

**MPN-Silikon-Epitaxiale-Planar-Transistor**  
 für Verstärker und schnelle Schalter


Metallgehäuse DIN 5 0 3

L1836C 10-N

Gewicht ca. 1,0g

Kollektor mit Gehäuse verbunden

Made in Iran

Emitterstrom

bei  $U_{CE} = 10\text{V}$  $I_{Em}$  1 (-) 100 mA

Leerlauf-Ausgangskapazität

bei  $U_{CE} = 10\text{V}$  $C_{ob}$  8,5 (-) 10 pF

Kurzschluss-Eingangskapazität

bei  $U_{CE} = 0,5\text{V}$  $C_{ib}$  50 (-) 60 pF

Transitfrequenz

bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 10\text{mA}$ ,  $f = 50\text{MHz}$  $f_T$  110 MHz

Wärmeleitfähigkeit

Sperrschicht - angebaute Luft

Sperrschicht - Gehäuse

 $R_{th(j-c)}$  < 104 gr/°K $R_{th(j-a)}$  < 35 gr/°K

## Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

 $U_{CB}$  120 V

V

Kollektor-Emitter-Spannung

 $U_{CE}$  80 V

V

Emitter-Basis-Spannung

 $U_{EB}$  7 V

V

Kollektorstrom

 $I_C$  1 A

A

Verlustleistung

bei  $T_C = 25^\circ\text{C}$ bei  $T_C = 100^\circ\text{C}$ bei  $T_C = 25^\circ\text{C}$  $P_{tot}$  0 W

W

 $P_{tot}$  2,8 W

W

 $P_{tot}$  0,9 W

W

Sperrschichttemperatur

 $T_j$  200 °C

°C

Kennwerte bei  $T_j = 25^\circ\text{C}$ 

Kollektor-Basis-Stromverstärkung

bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 0,1\text{mA}$  $\beta_{DC}$  30 (-) 20bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 10\text{mA}$  $\beta_{DC}$  45 (-) 35bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 100\text{mA}$  $\beta_{DC}$  50 (-) 30bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 500\text{mA}$  $\beta_{DC}$  50 (-) 30bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $I_C = 1000\text{mA}$  $\beta_{DC}$  30 (-) 15

Kollektor-Sättigungspannung

bei  $I_C = 0,5\text{A}$ ,  $I_B = 0,05\text{A}$  $U_{CE(sat)}$  < 0,25 Vbei  $I_C = 0,5\text{A}$ ,  $I_B = 0,05\text{A}$  $U_{CE(sat)}$  < 0,6 Vbei  $I_C = 1\text{A}$ ,  $I_B = 0,1\text{A}$  $U_{CE(sat)}$  < 1 V

Basis-Sättigungspannung

bei  $I_C = 1\text{A}$ ,  $I_B = 0,1\text{A}$  $U_{BE(sat)}$  < 1,5 V

Kollektorstrom

bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ bei  $U_{CE} = 10\text{V}$ ,  $T_C = 100^\circ\text{C}$  $I_{CM}$  0,5 (-) 10 mA $I_{CM}$  0,3 (-) 10 mA

\*) gemessen mit Impulsen